Wissenschaftliche(n) Mitarbeiter(in) / (m/w/d)
- Leiter(in) des InP Devices Lab -

Wir suchen die/den Leiterin/Leiter unseres InP Devices Lab.

(Kennziffer 25/19)

Die Höchstfrequenzelektronik im mm-Wellen- und Terahertz-Bereich zwischen 100 GHz und 1 THz ist ein sich dynamisch entwickelndes Forschungsfeld. Das FBH verfügt dazu über eine InP-Heterobipolartransistor-Technologie mit Grenzfrequenzen über 400 GHz. Das Aufgabengebiet des InP Devices Lab beinhaltet den Betrieb dieser Technologie zur Realisierung von Schaltungen sowie deren Weiterentwicklung zu Grenzfrequenzen bis 1 THz. Dies umfasst Aspekte des Bauelementdesigns, die Entwicklung geeigneter Halbleiter-Prozessmodule, die Charakterisierung und Modellierung von InP-HBT sowie die Mitgestaltung der Aufbautechnik dieser Höchstfrequenz-Chips. Das Equipment für diesen Prozess wird gerade im Rahmen der Forschungsfabrik Deutschland substantiell erweitert.

Das InP Devices Lab besteht zurzeit aus 5 wissenschaftlichen Mitarbeiterinnen/Mitarbeitern. Die/Der Leiterin/Leiter des Labs soll diese Gruppe führen, die technisch-wissenschaftlichen Ziele herausarbeiten und umsetzen, die Arbeiten intern koordinieren und mit den anderen Beteiligten in Technologie, Schaltungsentwurf und Messtechnik abstimmen. Dazu ist ein tiefgehendes Verständnis von Prozesstechnologie und Bauelement unerlässlich.

Voraussetzung ist eine abgeschlossene Promotion in den Bereichen Physik oder Elektrotechnik. Wünschenswert ist eine Schwerpunktsetzung im Bereich der Höchstfrequenztechnologie. Erfahrungen und Kenntnisse in den Aufgabenfeldern Transistor-Bauelementphysik, III-V-Halbleitertechnologie, Terahertz- und Mikrowellentechnik sind von Vorteil.

Wir suchen eine/ Teamplayerin/Teamplayer mit einem hohen Maß an Kommunikationsfähigkeit und Zuverlässigkeit für die Arbeit in einem multidisziplinären Team von Wissenschaftlerinnen/Wissenschaftlern und Technikerinnen/Technikern am FBH. Ausgezeichnete Sprachkenntnisse in Englisch und/oder Deutsch sind erforderlich.

Wir erwarten Einsatzbereitschaft, Flexibilität, die Fähigkeit zu selbständiger Forschungsarbeit sowie Beharrlichkeit und Gewissenhaftigkeit. Kenntnisse oder Erfahrungen im Bereich Diodenlaser, Halbleiter-Chipprozesstechnologie und elektro-optischer Charakterisierung sind vorteilhaft.

Die Stelle kann sofort besetzt werden und ist zunächst auf 2 Jahre befristet. Die Vergütung erfolgt nach TVöD (Bund).

Ein besonderes Augenmerk kommt der Gleichstellung der Geschlechter zu. Das Institut ist bestrebt, den Anteil von Frauen in diesem Bereich zu erhöhen. Daher sind Bewerbungen von Frauen besonders willkommen. Schwerbehinderte werden bei gleicher Eignung bevorzugt eingestellt.

Haben wir Ihr Interesse geweckt? Dann freuen wir uns auf Ihre Online-Bewerbung. Dazu klicken Sie bitte auf „Online bewerben“ und übermitteln uns auf diesem Wege Ihre vollständigen Bewerbungsunterlagen bis zum **04.10.2019.**

Falls Sie noch Fragen zur Bewerbung haben, wenden Sie sich bitte an Frau Nadine Kelm.
Tel.: 030 6392 2691
E-Mail: nadine.kelm@fbh-Berlin.de

Profil

Das Ferdinand-Braun-Institut, Leibniz-Institut für Höchstfrequenztechnik (FBH) im Forschungsverbund Berlin e. V. ist ein international führendes Forschungsinstitut auf den Gebieten der Diodenlaser, UV-LEDs und der Mikrowellen- und mm-Wellen-Bauelemente.

Auf der Basis von III/V Halbleitern erforscht und realisiert es Komponenten und Systeme u.a. für Anwendungen in Kommunikation, Verkehrs- und Produktionstechnik, Medizin und Biotechnologie. Es verfügt über die gesamte Wertschöpfungskette vom Design bis zu lieferfertigen Systemen.

Weiteres unter: www.fbh-berlin.de